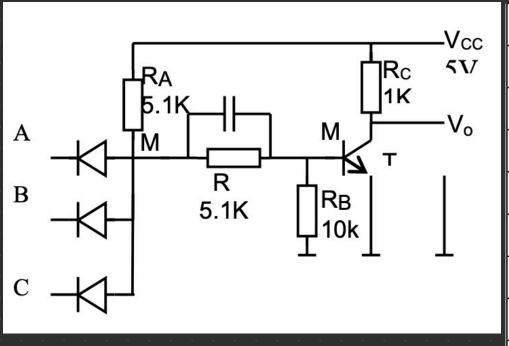
Circuite logice un drode si tranzistoare Poarte Si-Nu cu deplasare de nivel prin resistente

(1) Scopul luciario

Se va realiza un circuit Si-Mu cu componente discrete cu deplasare de nivel prin resistente. Pe circuitul realizat se von masura parametrii statici si dinamici ai acestuia.

(2) Functionere porti



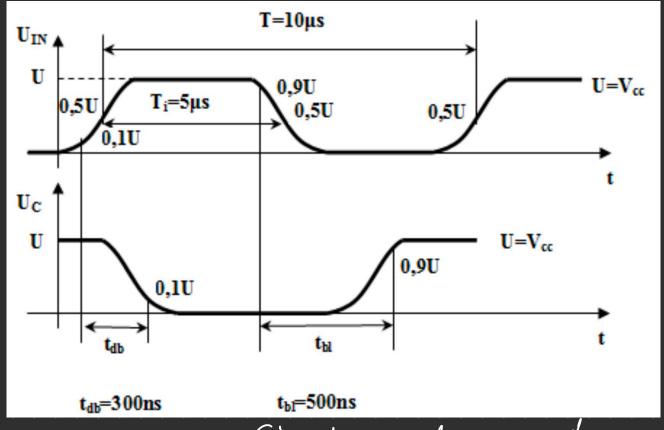
A	В	C	V_{BE}	F
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0,75	0

- (1) montaj (2) catalog diade (3) verifican circ.
- (4) masurone parametri statici -> curent de intrare maxim -> curent de resine monim

 - bese transistanten. -> tensiumile în punctul M,

(5)
$$t_{i} = 5 \mu s$$
 $V_{I} = 0 V$, $V_{A} = V_{S} = 5 V$

 $R_{A1} = 5.8 \text{ k}\Omega, R_{A2} = 4.8 \text{ k}\Omega, R_{A3} = 10.6 \text{ k}\Omega;$ T = 10 pes $R_{B1} = 5.8 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 6.4 \text{ k}\Omega$, $R_{B3} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{B4} = 17.8 \text{ k}\Omega$; $R_{C1} = 0.5 \text{ k}\Omega$, $R_{C2} = 0.9 \text{ k}\Omega$, $R_{C3} = 2.7 \text{ k}\Omega$.



- de comutere (7) trupi (6) esciloscop
- C1 = 190 pF cynstère 121istente (9) C2= 300 pF C3= 1000 pF

$$R_{B_1} = 5,6k.\Omega$$
 $R_{C_1} = 2,5k.\Omega$
 $R_{B_2} = 6,4k.\Omega$ $R_{2} = 2,9k.\Omega$
 $R_{B_3} = 10k.\Omega$ $R_{C_3} = 2,7k.\Omega$
 $R_{B_1} = 17,6k.\Omega$

	RA	R	$\mathcal{R}_{\mathcal{C}}$	Td6[ms]	- 768 Cm	
	PAn		2 3	92 90 88	7,2 1,85	
		2	1 2 3	90 96 100	2,4 2,2 2	
			1 2 3	30 94 100	3,6 3,3 3	
		4	1 2 3	85 86 90	7,0 6,6 4,9	
	R ₄₂		1 よ ら	99 94 105	2,2 2 1,8	
		2	1	50 S6 100	2, 4 2, 1	

RA	R	\mathcal{R}_{C}	tdb [ma]	- 768 [ms]
RAZ	3	2	90 95 105	3,6 3,2 2,8
	4	1 2 3	85 32 100	6,8 5,6 4,6
RA3		1 2 3	92 98 105	1,6 1,36 1,2
	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3	88 30 100	1,85 1,6 1,3
	3	1 2 3	84 88 94	2,6 2,4 2,1
	4	1 2 3	80 86 95	4,7 4 3,4